

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】令和 4 年 4 月 14 日(2022.4.14)

【公開番号】特開 2021-111676(P2021-111676A)

【公開日】令和 3 年 8 月 2 日(2021.8.2)

【年通号数】公開・登録公報 2021-034

【出願番号】特願 2020-1869(P2020-1869)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/338(2006.01)

10

H 0 1 L 29/06(2006.01)

H 0 1 L 21/336(2006.01)

H 0 1 L 21/8234(2006.01)

H 0 1 L 21/822(2006.01)

H 0 1 L 27/06(2006.01)

【F I】

H 0 1 L 29/80 H

H 0 1 L 29/80 E

H 0 1 L 29/06 3 0 1 F

H 0 1 L 29/78 3 0 1 B

H 0 1 L 27/06 1 0 2 A

H 0 1 L 27/04 G

H 0 1 L 27/06 3 3 1

20

【手続補正書】

【提出日】令和 4 年 4 月 6 日(2022.4.6)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 3

【補正方法】変更

30

【補正の内容】

【0 0 2 3】

この例では、第 1 絶縁膜 6 1 の一部 6 1 p から第 1 半導体層 1 0 へ方向は、第 1 方向（Z 軸方向）に対して垂直である。例えば、ゲート電極 5 1 の少なくとも一部から第 2 半導体層 2 0 の少なくとも一部へ方向は、第 1 方向（Z 軸方向）に対して垂直である。半導体装置 1 1 0は、ノーマリオフ動作が可能でも良い。実施形態において、ゲート電極 5 1 の少なくとも一部から第 1 半導体層 1 0 の少なくとも一部へ方向は、第 1 方向に対して垂直でも良い。

40

50